計測自動制御学会東北支部第 201 回研究集会(2002.5.22) 資料番号 201-7

金属酸化物薄膜を用いた代謝物センサの構成

Construction of Metabolite Sensor Utilizing Metal Oxide Thin-Film

谷地 善光,千葉 茂樹,長田 洋,関 享士郎

Yoshimitsu YACHI, Shigeki CHIBA, Hiroshi OSADA and Kyoshiro SEKI

岩手大学

Iwate University

キーワード:金属酸化物薄膜(metal oxide thin-film),真空蒸着法(vacuum deposition method) 代謝物センサ(metabolite sensor),酵素反応(enzyme reaction)

連絡先:〒020-8551 岩手県盛岡市上田 4-3-5 岩手大学工学部電気電子工学科 電子システム工学講座

長田 洋, Tel.: 019(621)6381, Fax.: 019(621)6381, E-mail: osada@dragon.elc.iwate-u.ac.jp

1.緒 言

近年,生体化学分野へのエレクトロニク ス技術の導入により,各種のバイオセンサ が開発されている.エレクトロニクス技術 は,主にトランデューサー部に用いられ, 測温素子としてはサーミスタ薄膜が広く実 用化されている.しかし,サーミスタ薄膜 の作製はスパッタ法によるものであり,真 空蒸着法による金属酸化物薄膜の作製は,金 属酸化物の融点が高いことや,金属酸化物の 蒸着量の制御が困難なため,均一のものが得 られ難く,これまでほとんど検討されていな かった.

そこで本研究では,真空蒸着法を用いて 比較的融点の低い金属(Fe,Ni,Mn等)の 多層膜を形成後,高温でアニーリング処理 を施して金属酸化物に転換する薄膜作製方 法を開発した.本方式では,アニーリング 処理前後の金属成分比に大きな変化が見ら れず良好な再現性が得られる.この方法を 用いて作製した金属酸化物薄膜 MOT(Metal Oxide Thin-Film) は,温度変化に伴い著し く抵抗値が変化する半導体特性を有してお り,10⁻² ~ 10⁻³ の微小な温度変化を計 測する高感度温度センサとして活用でき る.

ここでは MOT の作製と、その応用として MOT をセンサとして用いて酵素反応熱に より科学物質を識別、定量する代謝物セン サシステムを構成した.また、酵素反応に 対応した論理回路的シミュレーションを行 って、代謝メカニズムの解析を試みた.







図 2 MOT の抵抗 - 温度特性

2. MOT の作製と基礎特性

図1にMOTの作製工程を示す.基板上に 金属多層膜 MMF (Metal Multilayered Film) を形成する.なお,MOTは,サーミスタの 主原料を参考にして,Fe,Ni,Mnからなる 3層の金属多層膜とした.

真空蒸着装置を用いて MMF の膜厚が約 1.0 μm となるように,各層を抵抗加熱法に より蒸着した.なお,重量成分比は,Fe: Ni:Mn =1:2:3となるように調整した. 基板は耐熱性があり,かつ,試料に電気的 な影響を与えないアルミナ基板を用いた. 次いで,電気炉にてアニーリング処理を行 った後,両端に銀電極を蒸着すると MOT が作製される.なお,アニーリング処理は, 雰囲気を大気とした電気炉により大気雰囲 気中で,昇温(30分),温度保持(温度: 1000,時間:30分),冷却(9時間)の プロセスで行った.アニーリング処理にお ける最高温度での定温保持工程において, Fe,Ni,Mnの各金属層は,固溶体となり炉 内の酸素と結合して金属酸化物に転換す る.冷却工程は薄膜にクラックが生じる危 険性を回避するため,徐冷(冷却時間を約 9時間)とした.

図2は,MOTの電気抵抗の温度特性を示す.同図より,MOTの抵抗は温度上昇に伴い減少する傾向が見られ,顕著な温度依存性を有することがわかる.



図3 代謝物センサの構成



に対する応答特性

3. 代謝物センサの酵素反応特性

図3は,MOTを用いた代謝物センサシス テムを示す.試料溶液をビーカ(容量10ml) に入れ,この中心にMOTを設置する.酵素 溶液をマイクロチューブポンプにより一定 の速度と量で注入すると,ビーカ内で酵素 反応が起こり,反応熱が発生する.この酵 素反応熱をMOTで検出し,ブリッジ回路に より電気信号に変換して出力する.ブリッ ジ回路の印加電圧は2.0 V である.また,反 応熱が微少であるため,外部からの熱的干 渉を抑えるため,試料の入ったビーカをウ オータジャケット(容量50ml)内部に設置 し,さらに全体を恒温槽内に配置して,一 定温度(35))に保持した.

図 4 は,精製水および被測定物質として D グルコース溶液(濃度:1.0~3.0×10⁻² mol/1,容量:5 ml)を用い,グルコースオ キシターゼ酵素溶液(0.1 wt%,0.5 ml)を 滴下したときの出力電圧 Vo の特性を示す. また,これら2 つの溶液の反応式は下式で 表され,この反応系のエンタルピー変化 ΔH は-80.0 kJ/mol である.

 $D- \mathcal{J} h \exists - \mathsf{X} + O_2 \xrightarrow{\mathcal{J} h \exists - \mathsf{X} \neq \flat \varphi + \mathcal{U}}$ グルコノ - ラクトン + H_2O_2



図 5 D グルコースの濃度 - 出力特性

同図より,精製水へ酵素溶液を滴下した場 合には,エンタルピー変化を伴わないため, 応答を示さないが D グルコースに対して はパルス状の反応が見られる.また,濃度 が高くなるに従って,出力電圧のピーク値 も増大し,8.2 mV,15.9 mV,23.8 mVの値 を示した.また,いずれの濃度においても, パルス状出力電圧発生後,次第に元の値に 戻るため,本システムが酵素反応熱のみを 検知していることが分かる.

図 5 は D グルコースの濃度と出力電圧 のピーク値 V_pとの関係を示す.同図より, 濃度と出力電圧のピーク値との間に直線的 な関係が得られた.したがって,同図を検 量線として用いることで,出力電圧のピー ク値から被測定物質の定量が可能である.



(a) グルコース単体



(b)ペニシリン単体

図 6 単体溶液に対する酵素反応の 選択性

4.酵素反応の選択性に関する実験

酵素は,特定の物質にしか反応しないと いう反応特異性を有している.反応特異性 を確認するために,種々の実験を行った. なお,実験で用いた試料溶液及び酵素は, それぞれ同濃度,同容量(試料溶液:1.0× 10⁻² mol/1,5 ml,酵素:0.1 w%,0.5 ml)で ある.

図 6(a)は,D グルコース単体溶液に ペニシリナーゼ,グルコースオキシターゼ, 及びその2種類の混合酵素をそれぞれ滴下 した際の応答特性である.ペニシリナーゼ を滴下した際は応答が無かったが,グルコ ースオキシターゼを滴下した際は,8.2 mV のピーク値をもつパルス電圧が生じた.混 合酵素を滴下した際もほぼ同じ波形が得ら れた.

図6(b)は、ペニシリン単体溶液にそれ ぞれの酵素を滴下した際の応答特性であ る.ペニシリナーゼと混合酵素を滴下した 際は、6.5 mVのピーク値をもつほぼ同じ波 形のパルス電圧が生じたが、グルコースオ キシターゼを滴下した際は応答が無かっ た.これらの結果から、試料溶液である基 質は特定の酵素にのみ応答し、他の酵素に は応答しないという鋭い選択性を有してい るため、この現象を用いて各種の生体物質 の識別が可能である.



図7 混合溶液に対する酵素反応の選択性

図7はD グルコースとペニシリンの混 合試料溶液に対してそれぞれの酵素を滴下 した場合の応答特性である.混合溶液に対 しては,パルス波形及びピーク値が異なり, ペニシリンとペニシリナーゼD グルコー スとグルコースオキシターゼがそれぞれ反 応しており,試料が多成分系であっても厳 密に反応選択性を再現できることが分か る.また,混合酵素を滴下した際は,凹凸 のある波形が得られた.これは,それぞれ の酵素と試料が反応する際の応答時間の差 (ペニシリンとペニシリナーゼは約90秒, D グルコースとグルコースオキシターゼ は約10秒)によるものであると思われる.

5.論理回路シミュレーション

以上より,MOT を用いた代謝物センサ は,被測定物質に対し,特定の酵素に反応 して発熱し,鋭いパルス電圧を発生させ, そのピーク値は,試料や酵素の種類や濃度 によって種々変化することが分かった.ま た,基質は特定の酵素にのみ応答し,他の 酵素には応答しないという鋭い選択性を有 しているので,この現象を用いて各種の生 体物質を識別できる.そこで,酵素反応の 論理的なシミュレーションを試みた.

図 8 は,単体試料溶液と2 種類の酵素と の応答特性(図 6 の実験結果)を表したも のである.試料溶液(D グルコース:Dg, ペニシリン:Pg)に対して,酵素(グルコ ースオコシターゼ:Go,ペニシリナーゼ: Pn)を入力した場合の選択性を伴う酵素反 応の論理的シミュレーション(出力 X)を 示す.入力はそれぞれの酵素を注入する場 合を1,しない場合を0とし,出力は反応 する場合を1,しない場合を0とした.(a) 図は,図6(a)に対応しており,グルコー スオコシターゼ:Goを入力した場合に応答 (出力 X₁)があることを示す.また,(b) 図は,図6(b)に対応しており,ペニシリ ナーゼ:Pnを入力した場合に応答があるた め,X₂は同図のように表現できる.

図 9 は,図 7 の実験結果を基に,しきい 値を変化させた場合の論理的シミュレーシ ョン(出力 Y)を示す.同図(a)の回路図 で,Dg と Pg に対する応答電圧の小さい方 (この場合 Pg)をしきい値とすると,(a) に示す論理和的な真理値となり,Dg と Pg に対する応答電圧の和をしきい値とする と,(c)に示す論理積的な真理値となる.

Go — Dg Pn —)— 出	力 Xı	Go — Pn —	Pg	¥ —<	」カ X ₂
入力	出力)	、カ	出力	
Go Pn	X ₁		Go	Pn	X_2	
$\begin{array}{ccc} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array}$	0 0 1 1		0 0 1 1	0 1 0 1	0 1 0 1	
(a)			(b)			

図8 単体試料溶液との応答結果



図9 混合試料溶液との応答結果

6. 結言

以上,代謝物センサの酵素反応特性と論 理回路シミュレーションについて報告し た.酵素反応には,定量と識別の反応特異 性があり,特に識別に関する応答特性を論 理的にシミュレーションした結果は,生体 物質の代謝メカニズムの解析に有効である と思われる.

参考文献

- (1) 伊藤,谷地,久保田,徳田,千葉,長田,
 関:計測自動制御学会東北支部第194回
 研究集会,194-11(2001)
- (2)谷地善光,長田洋,千葉茂樹,関享 士郎:TOF 高感度温度センサの作製と酵素反応熱検出への応用,電子通信情報学 会論文誌C,Vol.J83-C,No.9,pp.1-7(2 000)
- (3)谷地善光,千葉茂樹,長田 洋,岡 英夫,関 享士郎:感温金属酸化物半導体 薄膜の作製と酵素センサへの応用,粉体 および粉末冶金協会誌, Vol.47, No.8, pp. 838-843 (2000)
- (4) Y.Yachi, S.Chiba, H.Osada, H.Oka,
 O.Michikami, N.Tayama and K.Seki : Magnetic Enzyme Sensor Utilizing Pyro Magnetic Film, IEEE Trans. Magn., Vol.36,
 No.5, pp.3730-3732 (2000)
- (5) Yoshimitsu Yachi, Kiyotaka Ito, Shigeki Chiba, Hiroshi Osada, Keiichi Sasaki, Masao Takahashi, Tsuneo Kubota, Kyoshiro Seki : Thermal Enzyme Sensor Utilizing Temperature-Sensitive Magnetic Thin Film, JJAP, Vol.41, No.2 (2002)